
Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module
TT425N

TT425N...

TD425N

DT425N

TD425N...-A

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

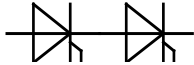
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$	$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	1000 1400	1200 1600 1800	V V V ¹⁾
Vorwärts-Stoßspitzenspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$	V_{DSM}	1000 1400	1200 1600 1800	V V V
Rückwärts-Stoßspitzenspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$	V_{RSM}	1100 1500	1300 1700 1900	V V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current		I_{TRMSM}		800	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_{\text{C}} = 85^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{C}} = 74^{\circ}\text{C}$	I_{TAVM}		425 510	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	I_{TSM}		14500 12500	A A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	I^2t		1051000 781000	A ² s A ² s
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f = 50 \text{ Hz}, i_{\text{GM}} = 1 \text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	$(di_{\text{T}}/dt)_{\text{cr}}$		120	A/ μs
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}, v_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 6.Kennbuchstabe / 6 th letter F	$(dv_{\text{D}}/dt)_{\text{cr}}$		1000	V/ μs

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}, i_{\text{T}} = 1500 \text{ A}$	v_{T}	max.	1,5	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}$	$V_{(\text{TO})}$		0,9	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj \max}$	r_{T}		0,3	m Ω
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6 \text{ V}$	i_{GT}	max.	250	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6 \text{ V}$	V_{GT}	max.	1,5	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj \max}, v_{\text{D}} = 6 \text{ V}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	i_{GD}	max. max.	10 5	mA mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	V_{GD}	max.	0,2	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6 \text{ V}, R_{\text{A}} = 5 \Omega$	i_{H}	max.	300	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6 \text{ V}, R_{\text{GK}} \geq 10 \Omega$ $i_{\text{GM}} = 1 \text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}, t_{\text{g}} = 20 \mu\text{s}$	i_{L}	max.	1500	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse current	$T_{vj} = T_{vj \max}$ $v_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, v_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$	$i_{\text{D}}, i_{\text{R}}$	max.	80	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{\text{GM}} = 1 \text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	t_{gd}	max.	4	μs

1) 1800V auf Anfrage/ 1800V on request

prepared by:	C.Drilling	date of publication:	19.12.02
approved by:	J. Novotny	revision:	1



Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module
TT425N
Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
 Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\max}$, $i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\text{ V}$, $V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}$, $-di_T/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ 5.Kennbuchstabe / 5 th letter O	t_q	typ.	250	μs
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{ Hz}$, $t = 1\text{ min}$ RMS, $f = 50\text{ Hz}$, $t = 1\text{ sec}$	V_{ISOL}		3,0 3,6	kV kV

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

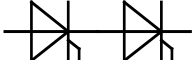
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Modul / per Module, $\Theta = 180^\circ\text{ sin}$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^\circ\text{ sin}$ pro Modul / per Module, DC pro Zweig / per arm, DC	R_{thJC}	max.	0,0390	$^\circ\text{C}/\text{W}$
			max.	0,0780	$^\circ\text{C}/\text{W}$
			max.	0,0373	$^\circ\text{C}/\text{W}$
			max.	0,0745	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per Module pro Zweig / per arm	R_{thCH}	max.	0,01	$^\circ\text{C}/\text{W}$
			max.	0,02	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\max}$		125	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\text{ op}}$		-40...+125	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}		-40...+130	$^\circ\text{C}$

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex				Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact					
Innere Isolation internal insulation				AIN	
Anzugsdrehmoment für mechanische Anschlüsse mounting torque	Toleranz / Tolerance $\pm 15\%$	M1		6	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque	Toleranz / Tolerance $\pm 10\%$	M2		12	Nm
Steueranschlüsse control terminals	DIN 46 244			A 2,8 x 0,8	
Gewicht weight		G	typ.	1500	g
Kriechstrecke creepage distance				19	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	$f = 50\text{ Hz}$			50	m/s^2
	file-No.			E 83336	

Mit diesem Datenblatt werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Es gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

This data sheet specifies semiconductor devices, but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.



Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module

TT425N

